

性能特点：

- 输出信号：-5V-0V
- 开关时间：20ns
- 芯片尺寸：1.36mm×0.9mm×0.1mm

产品简介：

HH-FEN4 是 4 位负压输出 FET 驱动器芯片，采用 GaAs 工艺制作，可将输入的 TTL 脉冲信号生成-5.1V/-0.3V 的互补脉冲信号输出。该产品可广泛应用于控制 FET 开关、数控衰减器、数控移相器等电路。

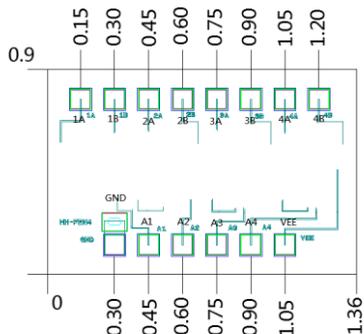
电参数： (TA=25°C, VEE=-5V)

指标	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
静态电流	I _{ees}	-	-	2	mA	-
驱动电流	I _o	-	0.2	-	mA	与负载有关
输入电流	I _i	-	0.2	-	mA	单路
输出高电平	V _h	-0.3	-	-	V	开路
输出低电平	V _l	-5.1	-	-	V	开路
开关时间	t _s	-	15	-	ns	f=100KHz
工作频率	f	-	10	-	MHz	与负载有关

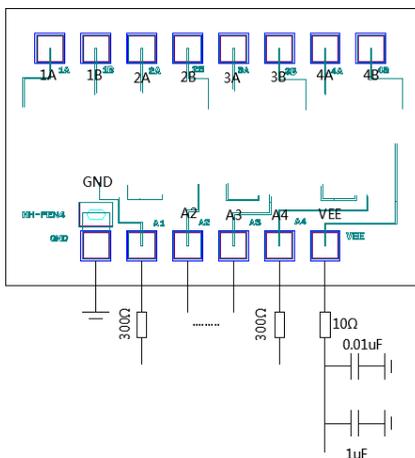
真值表：

VEE=-5V		
输入(V)	输出(V)	
A1	1A	1B
0	-5	0
5	0	-5
A2	2A	2B
0	-5	0
5	0	-5
A3	3A	3B
0	-5	0
5	0	-5
A4	4A	4B
0	-5	0
5	0	-5

尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。